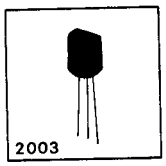
查询2SA1017供应商

2SA1017
2SC2363

低周波電力増幅
40～50W出力
プリドライバ用

PNP/NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor

For Predriver of 40 to 50 W AF Amplifier



★A complementary pair.
★( ) shows 2SA1017 only.
★For the details, see 2SC2363 section.

Ⓒ C511B

( )内は 2SA1017の場合を示す.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/T_a=25°C

			unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	(−) 120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	(−) 100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	(−) 5	V
コレクタ電流	I_C	(−) 50	mA
ピークコレクタ電流	i_{cp}	(−) 100	mA
コレクタ損失	P_C	500	mW
接合部温度	T_j	125	°C
保存周囲温度	T_{stg}	−55～+125	°C

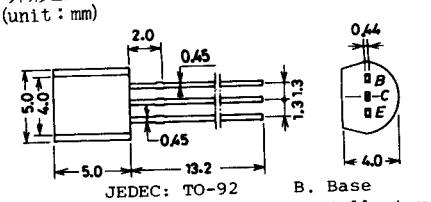
電気的特性 Electrical Characteristics/T_a=25°C

			min	typ	max	unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=(−) 80V, I_E=0			(−) 1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=(−) 4V, I_C=0			(−) 1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}※	V_{CE}=(−) 6V, I_C=(−) 1mA	100※		560※	
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=(−) 6V, I_C=(−) 1mA		(110) 130		MHz MHz
出力容量	c_{ob}	V_{CB}=(−) 10V, f=1MHz	(1.0) 1.0	(2.2) 1.8	(3.0) 2.5	pF pF
C−E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=(−) 10mA, I_B=(−) 1mA			(−) 0.5	V
C−B 降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=(−) 10μA, I_E=0	(−) 120			V
C−E 降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=(−) 1mA, R_{BE}=∞	(−) 100			V
E−B 降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=(−) 10μA, I_C=0	(−) 5			V

※ 2SA1017, 2SC2363は 1mA h_{FE} によりつぎのように分類している.

100	E	200	160	F	320	280	G	560

外形図 2003
(unit : mm)



JEDEC: TO-92
EIAJ : SC-43
SANYO: NP

B. Base
C. Collector
E. Emitter

※詳しくは2SC2363のページをご覧ください.